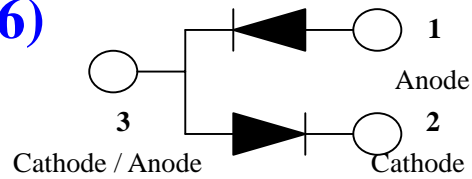




Switching Diode (FHD226)



开关二极管

MAXIMUM RATINGS 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Maximum (Peak) Reverse Voltage 峰值反向电压	V_{RM}	85	Vdc
Reverse Voltage 反向电压	V_R	80	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	I_{FM}	300	mAdc
Average Forward Current 正向平均电流	I_O	100	mAdc
Surge Current 浪涌电流 (10ms)	I_{FSM}	2	A
Power Dissipation 耗散功率	P_D	225	mW
Junction Temperature 结温	T_j	150	
Storage Temperature Range 储存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	

DEVICE MARKING 打标

FHD226=C3

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性($T_A=25$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	TYP 典型	Max 最大值	Unit 单位
Forward Voltage 正向电压	V_{F1}	$I_F=1\text{mAdc}$	—	0.60	—	V
	V_{F2}	$I_F=10\text{mAdc}$	—	0.72	—	V
	V_{F3}	$I_F=100\text{mAdc}$	—	0.90	1.20	V
Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流	I_R	$V_R=80\text{Vdc}$	—	—	0.5	μAdc
Total Capacitance 电容	C_T	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$	—	0.9	3.0	pF
Reverse Recovery Time 反向恢复时间	t_{rr}	$I_F=10\text{mA}$	—	1.6	4.0	nS